PAT-NO:

JP411329734A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 11329734 A

TITLE:

ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT

PUBN-DATE:

November 30, 1999

INVENTOR-INFORMATION:

NAME SATO, YOSHIHARU OGATA, TOMOYUKI COUNTRY N/A N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MITSUBISHI CHEMICAL CORP

N/A

APPL-NO: JP10139509

APPL-DATE: May 21, 1998

INT-CL (IPC): H05B033/14, C09K011/06, H05B033/22

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a white organic electroluminescent element having high luminous efficiency and improved stability.

SOLUTION: This light emitting element comprises at least: a hole transport

layer sandwiched between a positive electrode and a negative electrode, a light

emitting layer, and a hole blocking layer on a substrate, wherein the light

emitting layer contains an aromatic amine compound having a maximum

fluorescence wavelength in a range of 400 to 500 nm, the ionization potential

of the hole transport layer is larger than that of the light

06/04/2003, EAST Version: 1.03.0002

emitting layer by 0.1 eV or more, the ionization potential, of the hole blocking layer is larger than that of the light emitting layer by 0.2 eV or more, and at least the light emitting layer contains a fluorochrome whose maximum fluorescent wavelength is in a range of 550 to 650 nm.

COPYRIGHT: (C) 1999, JPO

06/04/2003, EAST Version: 1.03.0002

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-329734

(43)公開日 平成11年(1999)11月30日

		FΙ	識別記号	1.*	(51) Int.Cl.*
В	33/14	H05B	•	B 33/14	H05B
620	11/06	C 0 9 K	620	K 11/06	C09K
В	33/22	H05B		B 33/22	H05B
С					

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 22 頁)

(21)出願番号	特顧平10-139509	(71)出願人	
			三菱化学株式会社
(22)出顧日	平成10年(1998) 5月21日		東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
		(72)発明者	佐藤 佳晴
(31)優先権主張番号	特顧平10-57888		神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地
(32) 優先日	平10(1998) 3月10日		三菱化学株式会社横浜総合研究所内
(33) 優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	緒方 朋行
			神奈川県横浜市青菜区鳴志田町1000番地
			三菱化学株式会社横浜総合研究所内
		(74)代理人	
		(14/104/	THE DELTA SERVE

(54) 【発明の名称】 有機電界発光素子

(57)【要約】

【課題】 発光効率が高く、且つ安定性の向上した白色 有機電界発光素子の提供。

【解決手段】 基板上に、陽極及び陰極により挟持された正孔輸送層、発光層及び正孔阻止層を少なくとも含む有機電界発光素子であって、該発光層が400~500 nmの範囲に蛍光極大波長を有する芳香族アミン化合物を含有し、正孔輸送層のイオン化ポテンシャルが発光層のイオン化ポテンシャルより0.1 e V以上大きく、正孔阻止層のイオン化ポテンシャルが発光層のイオン化ポテンシャルより0.2 e V以上大きく、少なくとも発光層に蛍光極大波長が550~650 nmの範囲にある蛍光色素を含有させることを特徴とする有機電界発光素子。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に、陽極及び陰極により挟持され た正孔輸送層、発光層及び正孔阻止層を少なくとも含む 有機電界発光素子であって、該発光層が400~500 nmの範囲に蛍光極大波長を有する芳香族アミン化合物 を含有し、正孔輸送層のイオン化ポテンシャルが発光層 のイオン化ポテンシャルより0.1eV以上大きく、正 孔界止層のイオン化ポテンシャルが発光層のイオン化ポ テンシャルより0.2eV以上大きく、少なくとも発光 層に蛍光極大波長が550~650nmの範囲にある蛍 10 なくとも一個含むトリアゾール誘導体又は下記一般式 光色素を含有させることを特徴とする有機電界発光素 子。

【請求項2】 発光層に含まれる前記芳香族アミン化合 物が下記一般式(I)又は(II)で表わされる芳香族ア ミン化合物であることを特徴とする請求項1に記載の有 機電界発光素子。

【化1】

$$N-X-N$$
 (I)

(式中、Xは、各々置換基を有していてもよい二価の、 芳香族炭化水素基又は芳香族複素環基を表わし、A r1 ないしArfは、各々独立して、各々置換基を有してい てもよい、芳香族炭化水素基又は芳香族複素環基を表わ し、X及びAr1ないしAr4の中少なくとも一つは、 縮合芳香族環基である)

[4:2]

$$A_{r}^{5} A_{r}^{6}$$

$$A_{r}^{5} A_{r}^{6}$$

$$A_{r}^{5} A_{r}^{6}$$

$$A_{r}^{5}$$

$$A_{r}^{5}$$

$$A_{r}^{5}$$

$$A_{r}^{5}$$

$$A_{r}^{5}$$

(式中、ZはSi、Ge又はSnのいずれかの原子を表 40%環基を表わす)

わし、Ar9 及びAr10は、各々独立して、各々置換基 を有していてもよい、芳香族炭化水素基又は芳香族複素※

(IV)

(式中、R1 ないしR6 は、各々独立して、水素原子、 ★基、アリル基、シアノ基、アミノ基、アシル基、アルコ ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル基、アルケニル★50 キシカルボニル基、カルボキシル基、アルコキシ基、ア

* (式中、Yは窒素原子又は1,3,5-位に置換するべ ンゼン環を表わし、Aェ5 及びAェ6 は、各々独立し て、各々置換基を有していてもよい、芳香族炭化水素基 又は芳香族複素環基を表わす)

【請求項3】 発光層に含まれる前記蛍光色素の量が 0.1~10重量%の範囲にあることを特徴とする請求 項1又は2に記載の有機電界発光素子。

【請求項4】 正孔阻止層が、下記一般式 (III)若しく は(IV)で表わされる金鳳錯体、下記構造式(V)を少 (VI) で表わされるスチリル化合物の少なくとも一種で 構成されることを特徴とする請求項1ないし3のいずれ かに記載の有機電界発光素子。

【化3】

20

$$\begin{bmatrix}
R^2 & R^1 \\
R^3 & N \\
R^4 & N \\
R^5 & R^6
\end{bmatrix}_2$$
(III)

(式中、R1 ないしR6 は、各々独立して、水素原子、 ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル基、アルケニル 基、アリル基、シアノ基、アミノ基、アシル基、アルコ キシカルボニル基、カルボキシル基、アルコキシ基、ア ルキルスルホニル基、α-ハロアルキル基、水酸基、置 換基を有していてもよいアミド基、置換基を有していて もよい芳香族炭化水素基又は置換基を有していてもよい 芳香族複素環基を表わし、MはA1原子又はGa原子を 示し、Lは下記一般式 (IIIa)、 (IIIb) 又は、 (III 30 c) のいずれかの基を表わす)

【化4】

【化5】

3

ルキルスルホニル基、α-ハロアルキル基、水酸基、置 換基を有していてもよいアミド基、置換基を有していて もよい芳香族炭化水素基又は置換基を有していてもよい 芳香族複素環基を表わし、MはA1原子又はGa原子を 示す)

【化6】

[
$$\{\ell 7\}$$
]
Ar¹³
C=CH-Ar¹²-CH=C
Ar¹⁶
(VI)

(式中、Ar12は、各々、置換基を有していてもよい二 価の、芳香族炭化水素基又は芳香族複素環基を表わし、 Ar13ないしAr16は、各々独立して、各々置換基を有 していてもよい、芳香族炭化水素基又は芳香族複素環基 を表わすり

【請求項5】 正孔阻止層と陰極との間に電子輸送層を 設けたことを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに 記載の有機電界発光素子。

【請求項6】 正孔阻止層の膜厚が、0.5~30 nm の範囲にあることを特徴とする請求項1ないし5のいず れかに記載の有機電界発光素子。

【請求項7】 正孔輸送層が芳香族アミン化合物により 形成されることを特徴とする請求項1ないし6のいずれ かに記載の有機電界発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機電界発光素子 に関する。詳しくは、特定の芳香族アミンを含有する発 光層に特定の蛍光色素をドープした有機電界発光素子に 関する。本発明の有機電界発光素子は、高い発光効率の 白色発光が達成でき、また安定性が向上しているので、 フラットパネル・ディスプレイやマルチカラー表示素 子、或いは面発光体としての特徴を生かした光源等への 応用が期待される。

[0002]

【従来の技術】従来、薄膜型の電界発光 (EL)素子と しては、無機材料のII~VI族化合物半導体であるZn S、CaS、SrS等に、発光中心であるMnや希土類 元素 (Eu、Ce、Tb、Sm等) をドープしたものが 一般的であるが、上記の無機材料から作製したEL素子 は、

- 1) 交流駆動が必要(50~1000Hz)、
- 2) 駆動電圧が高い(~200V)、
- 3)フルカラー化が困難(特に背色)、
- 4)周辺駆動回路のコストが高い、

という問題点を有している。

【0003】しかし、近年、上記問題点の改良のため、 有機薄膜を用いたEL素子の開発が行われるようになっ た。特に、発光効率を高めるため、電極からのキャリア 一注入の効率向上を目的として電極の種類の最適化を行 い、芳香族ジアミンから成る正孔輸送層と8-ヒドロキ シキノリンのアルミニウム錯体から成る発光層とを設け た有機電界発光素子の開発 (Appl. Phys. Le tt., 51巻, 913頁, 1987年) により、従来 10 のアントラセン等の単結晶を用いたEL索子と比較して 発光効率の大幅な改善がなされている。また、例えば、 8-ヒドロキシキノリンのアルミニウム錯体をホスト材 料として、クマリン等のレーザ用蛍光色素をドープする こと (J. Appl. Phys., 65巻, 3610 頁、1989年)により、発光効率の向上や発光波長の 変換等も行われている。

【0004】上記の様な低分子材料を用いた電界発光素 子の他にも、発光層の材料として、ポリ(p-フェニレ ンビニレン) (Nature, 347巻, 539頁, 1 990年)、ポリ〔2-メトキシ-5-(2-エチルへ キシルオキシ)-1,4-フェニレンピニレン〕(Ap pl. Phys. Lett., 58卷, 1982頁, 1 991年 他)、ポリ (3-アルキルチオフェン) (J pn. J. Appl. Phys, 30巻, L1938 百.1991年)等の高分子材料を用いた電界発光素子 の開発や、ポリビニルカルバゾール等の高分子に低分子 の発光材料と電子移動材料を混合した素子(応用物理, 61巻、1044頁、1992年)の開発も行われてい

30 [0005]

【発明が解決しようとする課題】有機電界発光素子を用 いて、多色又はフルカラー表示が可能な表示素子を作製 するためには、二つの方法が考えられている。一つは、 青色の光を発光させることのできる有機電界発光素子を 励起光源として、縁及び赤の蛍光材料による蛍光変換を 用いる方法である (Proc. 15th Int. Di splay Research Conferenc e, 269頁, 1995年)。もう一つは、白色発光が 可能な有機電界発光素子とカラーフィルターを組み合わ 40 せる方式である(特開平7-142169号公報)。

【0006】前者の青色発光と蛍光変換の組み合わせに よる多色化、フルカラー化方式においては、青色有機電 界発光素子の性能、特に、駆動時の寿命が問題である。 これまでのところ、青色発光素子に関しては初期輝度1 00cd/m2 で、8000時間の寿命が報告されてい るが(Inorganic and OrganicE lectroluminescence/EL 96 Berlin, ed. R. H. Mauch and H. E. Gumlich, p. 95, Wissensc

50 haft und Technik Verlag,

Berlin)、蛍光変換によるロスや要求される実用 輝度300cd/m² を考えると、寿命が不十分なのが 現状である。

【0007】後者の白色有機電界発光素子とカラーフィ ルタを組み合わせる方式では、白色発光の発光効率が問 題であった(第55回応用物理学会学術講演会講演予稿 集、19p-H-6、992頁、1994年;第56回 応用物理学会学術講演会講演予稿集、28p-V-7、 1028頁、1995年)。白色発光に対しては、多色 化、フルカラー化への要求以外に、白色発光そのものを 10 表示光としたり、液晶ディスプレイ等のバックライトに 使用するニーズもあり、その波及効果は大きいと言え る。従って、表示素子の基本とでも言うべき白色発光に 対しては、更なる改良検討が望まれている。

【0008】白色発光を達成するために、これまで、青 色発光層、緑色発光層及び赤色発光層を積層する方式 (特開平6-207170号公報; 同平7-14216 9号公報) が開示されているが、駆動に伴う白色E Lス ペクトルの変化による色ずれや、再結晶ゾーンが複数の 層に跨がるために発光効率が低いという問題点があっ た。この点を解決するために、青、緑、赤の各蛍光色素 を発光層中に同時にドープすることが考えられ、塗布型 ポリマーでは塗布液調整の段階で各色の蛍光色素を混合 することにより容易に白色が得られるが(Appl.P hys. Lett., 64卷, 815頁, 1994 年)、ポリマーの場合、不純物の制御が困難なため発光 効率及び駆動安定性が実用には違いのが現状である。低 分子を用いた真空蒸着法により各色の蛍光色素を発光層 ホスト中にドープすることは可能であるが、同時に多数 の蒸着源の蒸着速度を制御して各蛍光色素のドープ量を 30 調整するので、実際の生産を考えると非常に困難である と言わざるを得ない。

【0009】上述の様に、白色発光素子に対しては、出 来るだけ単純な層構成、例えば、発光層は単層で、且 つ、発光効率が高く、白色の色ずれが起きにくく、しか。 駅動時に安定な特性が求められている。本発明は、 発光効率が高く、且つ安定性の向上した白色有機電界発 光素子を提供することを目的とする。

【発明が解決しようとする課題】本発明者らは、かかる 実状に鑑み鋭意検討した結果、特定の芳香族アミンを含 有する発光層に特定の蛍光色素をドープさせ、且つ正孔 輸送層、発光層及び正孔阻止層のイオン化ポテンシャル の相対関係を特定することにより上記課題を解決し得る ことを見い出し、本発明を完成するに至った。

[0011]

【課題を解決するための手段】即ち、本発明の要旨は、 基板上に、陽極及び陰極により挟持された正孔輸送層、 発光層及び正孔関止層を少なくとも含む有機電界発光素 光極大波長を有する芳香族アミン化合物を含有し、正孔 輸送層のイオン化ポテンシャルが発光層のイオン化ポテ ンシャルより0.1eV以上大きく、正孔阻止層のイオ ン化ポテンシャルが発光層のイオン化ポテンシャルより 0.2eV以上大きく、少なくとも発光層に蛍光極大波 長が550~650 n mの範囲にある蛍光色素を含有さ せることを特徴とする有機電界発光素子にある。

【発明の実施の形態】以下、本発明の有機電界発光素子 について、図面を参照しながら説明する。図1は本発明 に用いられる一般的な有機電界発光素子の構造例を模式 的に示す断面図であり、1は基板、2は陽極、4は正孔 輸送層、5は発光層、6は正孔阻止層、8は陰極を各々 表わす。基板1は有機電界発光素子の支持体となるもの であり、石英やガラスの板、金属板や金属箔、プラスチ ックフィルムやシート等が用いられる。特にガラス板 や、ポリエステル、ポリメタクリレート、ポリカーボネ ート、ポリスルホン等の透明な合成樹脂の板が好まし い。合成樹脂基板を使用する場合にはガスバリア性に留 意する必要がある。基板のガスバリヤ性が小さすぎる と、基板を通過した外気により有機電界発光素子が劣化 することがあるので好ましくない。このため、合成樹脂 基板の少なくとも片面に緻密なシリコン酸化膜等を設け てガスバリア性を確保する方法も好ましい方法の一つで ある。

【0013】基板1上には陽極2が設けられるが、陽極 2は正孔輸送層への正孔注入の役割を果たすものであ る。この陽極は、通常、アルミニウム、金、銀、ニッケ ル、パラジウム、白金等の金属、インジウム及び/又は スズの酸化物等の金属酸化物、ヨウ化銅等のハロゲン化 金属、カーボンブラック、或いは、ポリ(3ーメチルチ オフェン)、ポリピロール、ポリアニリン等の導電性高 分子等により構成される。陽極2の形成は通常、スパッ タリング法、真空蒸着法等により行われることが多い。 また、銀等の金属微粒子、ヨウ化銅等の微粒子、カーボ ンブラック、導電性の金属酸化物微粒子、導電性高分子 微粉末等の場合には、適当なバインダー樹脂溶液に分散 し、基板1上に塗布することにより陽極2を形成するこ ともできる。更に、導電性高分子の場合は電解重合によ り直接基板 1 上に薄膜を形成したり、基板 1 上に導電性 高分子を塗布して陽極2を形成することもできる(Ap pl. Phys. Lett., 60卷, 2711頁, 1 992年)、陽極2は異なる物質で積層して形成するこ とも可能である。陽極2の厚みは、必要とする透明性に より異なる。透明性が必要とされる場合は、可視光の透 過率を、通常、60%以上、好ましくは80%以上とす ることが望ましく、この場合、厚みは、通常、5~10 00nm、好ましくは10~500nm程度である。不 透明でよい場合は陽極2は基板1と同一でもよい。ま 子であって、該発光層が400~500mmの範囲に蛍 50 た、更には上記の陽極2の上に異なる導電材料を積層す ることも可能である。

【0014】陽極2の上には正孔輸送層4が設けられる。正孔輸送層の材料に要求される条件としては、陽極からの正孔注入効率が高く、且つ、注入された正孔を効率よく輸送することができる材料であることが必要である。そのためには、イオン化ポテンシャルが小さく、可視光の光に対して透明性が高く、しかも正孔移動度が大きく、更に安定性に優れ、トラップとなる不植物が製造時や使用時に発生しにくいことが要求される。上記の一般的要求以外に、車載表示用の応用を考えた場合、業子には更に耐熱性が要求される。従って、Tgとして85で以上の値を有する材料が望ましい。

【0015】このような正孔輸送材料としては、例え ば、1、1-ビス(4-ジーp-トリルアミノフェニ ル)シクロヘキサン等の第三級芳香族アミン単位を連結 した芳香族ジアミン化合物 (特開昭59-194393 号公報) 4、4′-ビス [N-(1-ナフチル)-N -フェニルアミノ) ビフェニルで代表される二個以上の 第三級アミンを含み二個以上の縮合芳香族環が窒素原子 に置換した芳香族アミン (特開平5-234681号公 20 報)、トリフェニルベンゼンの誘導体でスターバースト 構造を有する芳香族トリアミン (米国特許第4,92 3,774号明細書)、N,N'ージフェニルーN, N'-ピス(3-メチルフェニル) ピフェニル-4. 4′-ジアミン等の芳香族ジアミン(米国特許第4.7 64,625号明細書)、分子全体として立体的に非対 称なトリフェニルアミン誘導体(特開平4-12927 ... 1号公報)、ピレニル基に芳香族ジアミノ基が複数個置 換した化合物(特開平4-175395号公報)、エチ レン基で第三級芳香族アミン単位を連結した芳香族ジア 30 ミン (特開平4-264189号公報)、スチリル構造 を有する芳香族ジアミン(特開平4-290851号公 報)、チオフェン基で芳香族第三級アミン単位を連結し たもの(特開平4-304466号公報)、 スターバー スト型芳香族トリアミン (特開平4-308688号公 報) ベンジルフェニル化合物 (特開平4-36415 3号公報)、フルオレン基で第三級アミンを連結したも の (特開平5-25473号公報)、トリアミン化合物 (特開平5-239455号公報)、ビスジピリジルア ミノビフェニル(特開平5-320634号公報)、 N, N, N-トリフェニルアミン誘導体 (特開平6-1 972号公報)、フェノキサジン構造を有する芳香族ジ アミン (特開平7-138562号公報)、ジアミノフ ェニルフェナントリジン誘導体(特開平7-25247 4号公報)、シラザン化合物(米国特許第4,950, 950号明細書)、シラナミン誘導体(特開平6-49 079号公報)、ホスファミン誘導体(特開平6-25 659号公報)、キナクリドン化合物等が挙げられる。 これらの化合物は、単独で用いてもよいし、必要に応じ て、各々、混合して用いてもよい。

【0016】上記の化合物以外に、正孔輸送層の材料として、ボリビニルカルバゾールやボリシラン(Appl. Phys. Lett.,59巻,2760頁,1991年)、ボリフォスファゼン(特開平5-310949号公報)、ボリアミド(特開平5-310949号公報)、ボリビニルトリフェニルアミン(特開平7-53953号公報)、トリフェニルアミン僧格を有する高分子(特開平4-133065号公報)、トリフェニルアミン単位をメチレン基等で連結した高分子(Synthetic Metals,55~57巻、4163頁、1993年)、芳香族アミンを含有するボリメタクリレート(J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed.,21巻,969頁,1983年)等の高分子材料が挙げられる。

【0017】上記の正孔輸送材料を塗布法或いは真空蒸

着法により前記陽極2上に積層することにより正孔輸送

層4を形成する。塗布法の場合は、正孔輸送材料を一種 又は二種以上と、必要により正孔のトラップにならない バインダー樹脂や塗布性改良剤等の添加剤とを添加し、 溶解して塗布溶液を調製し、スピンコート法等の方法に より陽極2上に塗布し、乾燥して正孔輸送層4を形成す る。バインダー樹脂としては、ポリカーボネート、ポリ アリレート、ポリエステル等が挙げられる。バインダー 樹脂は添加量が多いと正孔移動度を低下させるので、少 ない方が望ましく、通常、50重量%以下が好ましい。 【0018】真空蒸着法の場合には、正孔輸送材料を真 空容器内に設置されたルツボに入れ、真空容器内を適当 な真空ボンプで10-4Pa程度にまで排気した後、ルツ ボを加熱して、正孔輸送材料を蒸発させ、ルツボと向き 合って置かれた基板1上の陽極2上に正孔輸送層4を形 成させる。正孔輸送層4を形成する場合、更に、アクセ プターとして、 芳香族カルボン酸の金属錯体及び/又は 金属塩 (特開平4-320484号公報)、ベンゾフェ ノン誘導体及びチオベンゾフェノン誘導体 (特開平5-295361号公報)、フラーレン類(特開平5-33 1458号公報) 等を10-3~10重量%の濃度でドー プして、フリーキャリアとしての正孔を生成させること により、低電圧駆動を可能にすることができる。正孔輪 送層4の膜厚は、通常、10~300nm、好ましくは 40 30~100 n m である。この様に薄い膜を一様に形成 するためには、一般に真空蒸着法がよく用いられる。 【0019】陽極2と正孔輸送層4のコンタクトを向上 させるために、図3に示す様に、陽極バッファ層3を設 けることが考えられる。陽極バッファ層に用いられる材 料に要求される条件としては、陽極とのコンタクトがよ く均一な薄膜が形成でき、熱的に安定、即ち、融点及び ガラス転移温度が高く、融点としては300℃以上、ガ ラス転移温度としては100℃以上が要求される。 更 に、イオン化ポテンシャルが低く陽極からの正孔注入が 50、容易なこと、正孔移動度が大きいことが挙げられる。こ

の目的のために、これまでにポルフィリン誘導体やフタ ロシアニン化合物 (特開昭63-295695号公 報)、スターバースト型芳香族トリアミン (特開平4-308688号公報)、 ヒドラゾン化合物 (特開平4-320483号公報)、アルコキシ置換の芳香族ジアミ ン誘導体(特開平4-220995号公報)、p-(9 アントリル) - N、Nージーpートリルアニリン(特) 開平3-111485号公報)、ポリチエニレンビニレ ンやポリーpーフェニレンビニレン (特開平4-145 192号公報)、ポリアニリン (Appl. Phys. Lett., 64巻, 1245頁, 1994年参照) 等 の有機化合物や、スパッタ・カーボン膜(特開平8-3 1573号公報)や、バナジウム酸化物、ルテニウム酸 化物、モリブデン酸化物等の金属酸化物(第43回応用 物理学関係連合講演会,27a-SY-9,1996 年) が報告されている。

【0020】上記陽極バッファ層材料としてよく使用される化合物としては、ボルフィリン化合物又はフタロシアニン化合物が挙げられる。これらの化合物は中心金属を有していてもよいし、無金属のものでもよい。好まし20いこれらの化合物の具体例としては、以下の化合物が挙げられる:

ポルフィン

5,10,15,20ーテトラフェニルー 21H,23Hーポルフィン 5,10,15,20ーテトラフェニルー 21H,23Hーポルフィンコ バルト (II)

5,10,15,20ーテトラフェニルー 21H,23Hーポルフィン銅 (II)

5,10,15,20ーテトラフェニルー 21H,23Hーポルフィン亜 鉛(II)

5,10,15,20ーテトラフェニルー 21H,23Hーポルフィンバ ナジウム (IV) オキシド

5,10,15,20ーテトラ(4-ピリジル)- 21川,23H-ポルフィン

29H.31H -フタロシアニン

銅(II)フタロシアニン

亜鉛 (II) フタロシアニン

チタンフタロシアニンオキシド

マグネシウムフタロシアニン

鉛フタロシアニン

銅(II) 4, 4′, 4″, 4″′′ーテトラアザー29H, 31H - フタロシアニン

【0021】陽極バッファ層の場合も、正孔輸送層と同様にして薄膜形成可能であるが、無機物の場合には、更に、スパッタ法や電子ビーム蒸着法、プラズマCVD法が用いられる。以上の様にして形成される陽極バッファ層3の膜厚は、通常、3~100nm、好ましくは10~50nmである。

【0022】正孔輸送層4の上には発光層5が設けられ トンの 発光層5は、電界を与えられた電極間において、陽 50 る。

極2から注入された正孔輸送層を通過して輸送された正 孔と、陰極8から注入された正孔阻止層6を通過して輸 送された電子を効率よく再結合させることにより白色発 光する化合物より形成される。そのためには、正孔輸送 性と電子輸送性の両方を兼ね備え、しかも正孔移動度及 び電子移動度が大きく、更に安定性に優れトラップとな る不純物が製造時や使用時に発生しにくい化合物である ことが要求される。

【0023】本発明においては、発光層は、薄膜状態で 10 の蛍光極大波長が400~500 nmの範囲にある芳香 族アミン化合物をホスト材料として、分散状態又は希薄 溶液状態における蛍光極大波長が550~650 nmの 範囲にある蛍光色素を、上記ホスト材料に対して0.1 ~10重量%含有させることにより、高効率の白色発光 を可能とすることができる。このことを図4に示すC I E色度座標図 (JISZ8701) を用いて説明する。 白色発光は図中のWで示す白色点(x=y=1/3)を 中心とする領域で表わされる。400~500 nmに蛍 光極大波長を有する背色ホスト材料の発光は、図4では 青緑、青、青紫の領域に位置する。一方、蛍光極大波長 が550~650 nmのドーピング用蛍光色素の発光 は、図中の黄緑、黄、橙、赤の領域に対応する。例え ば、青紫色発光のホスト材料としてa点のものを使う場 合、ドープ色素として b 点のものを組み合わせると、加 法混色によりab線で表わされる色が達成され、ドープ 量を調整することで白色領域の発光が得られる。同様 に、青色ホスト材料として c 点のものとドープ色素とし て d 点のものを選べば、白色領域を幅広く横切る c d 線 が得られ、ドーピング濃度依存に緩やかに依存する白色 発光素子が達成される。ef線、ef′線についても同 30 様である。

【0024】本発明においては、上記の条件を満たす青 色ホスト材料として蛍光性芳香族アミン化合物を用い る。従来も、芳香族アミン化合物を正孔輸送性の発光層 として用いる試みはなされているが、正孔輸送層を陽極 との間に設けなかったり(Jpn. J. Appl. Ph ys., 32巻, L917頁, 1993年)、発光層の イオン化ポテンシャルが正孔輸送層のイオン化ポテンシ ャルより高かったり (Jpn. J. Appl. Phy 40 s., 35巻, 4819頁, 1996年) したために、 素子の発光効率も低く、また、安定性の低い青色発光素 子しか得られていなかった。本発明においては、正孔輪 送性の芳香族アミン化合物を発光層として有効に用いる ために、正孔輸送層のイオン化ポテンシャルより0.1 e V以上小さいイオン化ポテンシャルを有する蛍光性芳 香族アミンを用いることが好適であることを見出した。 この索子構造により、素子通電時の発光層における正孔 濃度を高めることと、発光層内での再結合によるエキシ トンの陽極での消光を防止することが同時に達成され

【0025】本発明の有機電界発光素子における発光層 材料として、正孔輸送層とのイオン化ポテンシャルの関係を満たす限りにおいて芳香族アミン化合物に更なる制限はないが、発光層の結晶化防止、熱安定性を考慮すると高いガラス転移温度(Tg)を有することが望ましい。高いTgを有する芳香族アミン化合物として、少なくとも一つの総合芳香族環基を置換基として有する第三級窒素原子を含有することが有用である。このことから、発光層に含まれる芳香族アミンが下記一般式(I) 又は(II)で表わされる芳香族アミン化合物から選ばれ10ることが更に好ましい。

【0026】 【化8】

$$\begin{array}{c}
Ar^{1} \\
N - X - N \\
Ar^{2}
\end{array}$$
(1)

【0027】前記一般式(I)において、好ましくは、 Xは、各々置換基を有していてもよい三価の、ベンゼン 環、ナフタレン環、アントラセン環、ビナフチル、フル 20 オレン環、フェナントレン環、ピレン環、アクリジン 環、フェナジン環、フェナントリジン環、フェナントロリン環、ビビリジル環、ビフェニルを示し、前記置換基 としてはハロゲン原子;メチル基、エチル基等の炭素数 1~6のアルキル基;ビニル基等のアルケニル基;メト キシカルボニル基、エトキシカルボニル基等の炭素数1 ~6のアルコキシカルボニル基等、エトキシ 基等の炭素数1~6のアルコキシカルボニルを基、エトキシ 基等の炭素数1~6のアルコキシ基;フェノキシ基、ベ ンジルオキシ基等のアリールオキシ基;ジエチルアミノ 基、ジイソプロピルアミノ基等のジアルキルアミノ基を 示す。前記置換基としては、特に好ましくは、メチル 基、フェニル基、メトキシ基が挙げられる。

【0028】Ar¹ ないしAr゚ は、好ましくは、各々独立して、各々置換基を有していてもよい、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、アントリル基、フェナントリル基、ピレニル基、ビリジル基、トリアジル基、ビラジル基、ナノキサリル基、チエニル基を示し、前記置換基としてはハロゲン原子;メチル基、エチル基等の炭素数1~6のアルキル基;ビニル基等のアルケニル基、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基等の 40 炭素数1~6のアルコキシ基、フェノキシ基、ベンジルオキシ基等のアリールオキシ基;フェノキシ基、ベンジルオキシ基等のアリールオキシ基;ジエチ

ルアミノ基、ジイソプロビルアミノ基等のジアルキルア ミノ基を示す。前記置換基としては、特に好ましくは、 メチル基、フェニル基、メトキシ基が挙げられる。

【0029】 【化9】

$$A_{I_{N}}^{5}A_{I_{n}}^{A_{I_{n}}}$$

$$A_{I_{n}}^{5}A_{I_{n}}^{A_{I_{n}}}$$

$$A_{I_{n}}^{5}$$

$$A_{I_{n}}^{5}$$

$$A_{I_{n}}^{5}$$

$$A_{I_{n}}^{5}$$

$$A_{I_{n}}^{5}$$

$$A_{I_{n}}^{5}$$

$$A_{I_{n}}^{5}$$

【0030】前記一般式 (II) において、Yは窒素原子 又は1.3.5-位に置換する三価のベンゼン環から選 ばれる。Ar5 及びAr6 は、好ましくは、各々独立し て、各々置換基を有していてもよい、フェニル基、ピフ ェニル基、ナフチル基、アントリル基、フェナントリル 基、ピレニル基、ピリジル基、トリアジル基、ピラジル 基、キノキサリル基、チエニル基を示し、前記置換基と してはハロゲン原子:メチル基、エチル基等の炭素数1 ~6のアルキル基; ビニル基等のアルケニル基; メトキ シカルボニル基、エトキシカルボニル基等の炭素数1~ 6のアルコキシカルボニル基:メトキシ基、エトキシ基 等の炭素数1~6のアルコキシ基 ; フェノキシ基、ベン ジルオキシ基等のアリールオキシ基; ジエチルアミノ 基:ジイソプロピルアミノ基等のジアルキルアミノ基を 示す。前記置換基としては、特に好ましくは、メチル 基、フェニル基、メトキシ基が挙げられる。

【0031】本発明においては、前記一般式(I)又は一般式(II)に示す分子構造により、Tgを85℃以上とすることができ、この耐熱性の向上により容易には結晶化しない非晶質薄膜を与えることが可能であり、正孔輸送層や電子輸送層等との間における分子の相互拡散を85℃以上の高温下でも十分に抑制することが出来る。また、イオン化ポテンシャルも正孔輸送層のそれより0.1eV以上小さくすることができ、また、400~500nmの波長領域に蛍光極大を有する発光層が設計できる。前記一般式(I)及び(II)で表わされる芳香族アミン化合物の好ましい具体例を表1ないし表5に示すが、これらに限定されるものではない。

[0032]

【表1】

13

Ar¹ Ar³
N—X—N
Ar² Ar⁴

接一1

番号	х	Aг [,]	Αr²	Ara	Ar*
(I-1).	-0-0-	\Diamond	8	-⊘	
(1-2)	-0-0-	-{>сн₃	-8	-{	\Diamond
(1-3)			H ₃ C	-⊘	H _S C
(1-4)	-0-0-	-			
(1-5)		\rightarrow	-0	$\overline{\ }$	
(1-6)	-0-0-	— CH₃	₹	√ >⇔	
(1-7)		{С}-осн₃	8	-{_>осн₃	8

[0033]

* *【表2】

ſ	-	1	I					
-	Ar⁴	φ	φ			\$		8
	Ar³	P	P	P	⇔ ces	P	P	P
-2	Ar²	φ	φ	8	\$	\$	8	-8
数-2	. Ar	P	P	P	§	Ŷ	Ŷ	P
	×	£\£	000	00	0	000	000	00
	中中	(i-8)	(6-1)	(1-10)	(1-11)	(1-12)	(1-13)	(1-14)

[0034]

* *【表3】

	17 18					100111		
	Ar⁴		φ		₩ .	$\varphi \circ$		0
	Ar³	9	8	N N	-Снз	0	-С-Сн₃	
表一3	Ar³				€ сн³			\$
- A	Ar¹	?	8	N N	СН3	?	← CH ₃	0
	×							00
	- 無	(1-15)	(1-16)	(1-12)	(1-18)	(1-19)	(1-20)	(1-21)

[0035]

* *【表4】

		19					. 2	0
	Are		8		ф.	0	ено 🔷	\$
	Ar³	P	9	P [*]	-О-он,	0	CH ₂	⊖ OH.
- 4	Ar²	Ŷ	φ		⇔	0	CH ₃	OH,
表—4	.	Ŷ	P	ှ	CH ₈	0	°ю 🔷	← GHs
	×	ф		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\$	**************************************		H36 CH3

[0036]

* *【表5】

(1-25)

(1-26)

(1-27)

(1-28)

(1-24)

(1-23)

(1-22)

22

Ar ⁵ _N . Ar ⁶					
表 一 5	Ars Ars	Ar ⁶			
番号	Ar ^s	Ar ^e	Υ		
(II-1)	$\overline{\langle}\rangle$	\rightarrow	N		
(II-2)	-⟨♡	CH₃	, N.		
(11-3)	Q CH₃	(CH ₃	, k		
(11-4)	− С≻сн₃	- ∕ CH ₃	人		
(II-5) _.			-k		
(11-6)	→				
(11-7)	→	$-\bigcirc$, k		
(8-11)	- ⊘	-⊘ .	Δ		
(11-9)	-🛇	→Q ^{CH3}			
(II-10)	- ⊘		\Diamond		
· (II-11)	_ - - - - - -	− C ₀			

【0037】これらの化合物は、単独で用いてもよい し、必要に応じて、各々、混合して用いてもよい。前記 芳香族アミン化合物をホスト材料として、発光層にドー 40 プされる蛍光色素としては、分散状態又は希薄溶液状態 における蛍光極大波長が550~650 nmの範囲にあ る蛍光色素であればよい。ここで分散状態又は希薄溶液 状態は蛍光色素の濃度消光が起こらない濃度範囲を意味 し、通常は10重量%以下である。黄緑から黄色の蛍光 を有する色素としては、例えば、ルブレンを代表とする ナフタセン誘導体(特開平4-335087号公報)、 ベリミドン誘導体(特開平4-320485号公報)、 橙色蛍光色素としては、ベンゾチオキサンテン誘導体

*昭63-264692号公報)、ローダミン色素等が、 赤色蛍光色素としては、アザベンゾチオキサンテン誘導 体 (特願平9-88172号明細書)、フェノキサゾン、DCJ色素 (Chem. Funct. Dyes, Proc. Int. Symp., 2nd 1992年, 536頁)、ルモゲンドレッド等のペリレン顔料等が挙げられる。上記の蛍光色素を青色ホスト材料に0.1~10重量%の濃度範囲においてドープすることで、ホスト材料からの発光にドープ色素からの発光を加えることにより所望の白色発光を得ることができる。

ペリミドン誘導体(特開平4-320485号公報)、 【0038】白色のバランスを採るために、また、発光 費色蛍光色素としては、ベンゾチオキサンテン誘導体 効率を向上させるために、400~500nmに蛍光極 (特開平5-222362号公報)、DCM色素(特開*50 大被長を希薄状態で有する蛍光色素を更にドープして加

2.4

えることも有効である。この目的に用いられるドープ色 素としては、例えば、ペリレン等の縮合多環芳香族環 (特開平5-198377号公報)、クマリン誘導体、 ナフタル酸イミド誘導体(特開平4-320486号公 報)、芳香族アミン誘導体(特開平8-199162号 公報)等が挙げられる。これらのドープ色素が、ホスト 材料に含有される割合は0.1~10重量%の範囲にあ ることが好ましい。上記400~500 nmの蛍光色素 は発光層中に均一にドープされてもよいし、部分的にド ープされてもよい。真空蒸着法で上記のドーピングを行 10 う方法としては、共蒸着による方法と蒸着源を予め所定 の濃度で混合しておく方法がある。尚、上記のドーピン グ濃度範囲内であれば、ホスト材料のイオン化ポテンシ ャルがドーピングにより変化することはない。

【0039】上記各ドーパントが発光層中にドープされ る場合、発光層の膜厚方向において均一にドープされる が、膜厚方向において濃度分布があったり、発光層に部 分的にドープされても構わない。例えば、正孔輸送層と の界面近傍にのみドープしたり、逆に、正孔阻止層界面 近傍にドープしてもよい。発光層5は、正孔輸送層4と 同様にして塗布法或いは真空蒸着法により正孔輸送層4 上に積層することにより形成される。但し、塗布法の場 合には既に薄膜形成されている正孔輸送層を溶解させな い溶媒を使用する必要がある。発光層5の膜厚は、通 常、5~300nm、好ましくは10~100nmであ る。この様に薄い膜を一様に形成するためには、一般に 真空蒸着法がよく用いられる。

【0040】発光層5の上には正孔阻止層6が設けられ る。正孔阻止層6は、発光層から移動してくる正孔を陰 極に到達するのを阻止する役割と、陰極から注入された 30 電子を効率よく発光層5の方向に輸送することができる*

*化合物より形成される。正孔阻止層を構成する材料に求 められる物性としては、電子移動度が高く正孔移動度が 低いこと、及び、正孔を効率的に発光層内に閉じこめる ために、発光層のイオン化ポテンシャルより0.2eV 以上大きいイオン化ポテンシャルの値を有する必要があ る。正孔輸送層は電子輸送能力を持たない材料で構成さ れることから、正孔阻止層は正孔と電子を発光層内に閉 じこめて、発光効率を向上させる機能を有する。このよ うな条件を満たす正孔阻止層材料としては、以下の一般 式 (111)で表わされる混合配位子錯体、

[0041]

【化10】

$$\begin{bmatrix}
R^2 & R^1 \\
R^3 & N
\end{bmatrix}$$

$$M-L \qquad (III)$$

【0042】(式中、R1 ないしR6 は、各々独立し て、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル 基、アルケニル基、アリル基、シアノ基、アミノ基、ア シル基、アルコキシカルボニル基、カルボキシル基、ア ルコキシ基、アルキルスルホニル基、α-ハロアルキル 基、水酸基、置換基を有していてもよいアミド基、置換 基を有していてもよい芳香族炭化水素基又は置換基を有 していてもよい芳香族複素環基を表わし、MはAI原子 又はGa原子を示し、Lは以下に示す一般式(IIIa)、 .(IIIb) 又は (IIIc) のいずれかの基を表わす)

[0043]

【化11】

$$-0-Ar^{7}$$
 (IIIa) $-0-C-Ar^{8}$ (IIIb) $-0-\frac{7}{7}-Ar^{10}$ (IIIc)

【0044】(式中、ZはSi、Ge又はSnのいずれ かの原子を表わし、Arg 又はArloは、各々独立し て、各々置換基を有していてもよい、芳香族炭化水素基 又は芳香族複素環基を表わす)

※以下の一般式 (IV) で表わされる二核金属錯体、 [0045] 【化12】

$$\begin{bmatrix} R^2 & R^1 \\ R^3 & N \\ R^4 & O \end{bmatrix}_2 MO-M \begin{bmatrix} R^1 & R^2 \\ N & R^3 \\ R^6 & R^6 \end{bmatrix}_2$$
 (IV)

【0046】(式中、R1 ないしR6 は、各々独立し て、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル 基、アルケニル基、アリル基、シアノ基、アミノ基、ア シル基、アルコキシカルボニル基、カルボキシル基、ア ルコキシ基、アルキルスルホニル基、α-ハロアルキル★50 以下の構造式(IV)で示される1,2,4-トリアゾー

★基、水酸基、置換基を有していてもよいアミド基、置換 基を有していてもよい芳香族炭化水素基又は置換基を有 していてもよい芳香族複素環基を表わし、MはA1原子 又はGa原子を示す)

ル環を少なくとも一個有する化合物、 [0047]

【化13】

【0048】以下の一般式(V)で示されるスチリル化 合物が挙げられる。

[0049]

【化14】

$$A_{1}^{13}$$
 C=CH- A_{1}^{12} -CH= A_{1}^{12} (VI)

【0050】(式中、Ar12は、各々置換基を有してい てもよい二価の、芳香族炭化水素基又は芳香族複素環基 を表わし、Ar13ないしAr16は、各々独立して、各々 置換基を有していてもよい、芳香族炭化水素基又は芳香 族炭化水素基を表わす)

前記一般式 (III)で示される混合配位子錯体の具体例と 20 して、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(フェノ ラト) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノ ラト (オルトークレゾラト) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラト) (メタークレゾラト) アル ミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラト) (パ ラークレゾラト) アルミニウム、ビス (2-メチル-8 ーキノリノラト) (オルトーフェニルフェノラト) アル ミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラト) (メ ターフェニルフェノラト) アルミニウム、ピス (2ーメ チルー8ーキノリノラト) (パラーフェニルフェノラ ト) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラ ト) (2.3-ジメチルフェノラト) アルミニウム、ビ ス(2-メチル-8-キノリノラト)(2,6-ジメチ ルフェノラト) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラト) (3、4-ジメチルフェノラト) アルミ ニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(3, 5ージメチルフェノラト) アルミニウム、ビス (2ーメ チル-8-キノリノラト) (3,5-ジーtert-ブ チルフェノラト) アルミニウム、ビス (2-メチルー8 ーキノリノラト) (2,6-ジフェニルフェノラト)ア 40 ルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト) (2, 4, 6-トリフェニルフェノラト) アルミニウ ム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(2,4, 6-トリメチルフェノラト) アルミニウム、ビス(2-メチルー8ーキノリノラト)(2,3,6ートリメチル フェノラト) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キ ノリノラト)(2,3,5,6-テトラメチルフェノラ ト) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラ ト) (1-ナフトラト) アルミニウム、ビス (2-メチ

ム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(トリフェ ニルシラノラト) アルミニウム、ビス (2-メチル-8 -キノリノラト) (トリフェニルゲルマノラト) アルミ ニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(トリ ス(4,4,-ピフェニル)シラノラト)アルミニウ ム、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラト)(オ ルトーフェニルフェノラト)アルミニウム、ビス(2. 4-ジメチル-8-キノリノラト) (パラーフェニルフ ェノラト) アルミニウム、ビス(2,4-ジメチルー8 10 -キノリノラト) (メターフェニルフェノラト) アルミ ニウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラト) (3, 5-ジメチルフェノラト) アルミニウム、ビス (2, 4-ジメチル-8-キノリノラト) (3, 5-ジ -tert-ブチルフェノラト) アルミニウム、ビス (2-メチル-4-エチル-8-キノリノラト) (パラ ークレゾラト) アルミニウム、ビス (2-メチル-4-メトキシー8-キノリノラト)(パラーフェニルフェノ ラト) アルミニウム、ビス (2-メチルー5-シアノー 8-キノリノラト) (オルトークレゾラト) アルミニウ ム、ビス(2-メチルー6-トリフルオロメチルー8-キノリノラト) (2ーナフトラト) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラト) (フェノラト) ガリ ウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラト) (オルト ークレゾラト)ガリウム、ビス(2ーメチルー8ーキノ リノラト) (パラーフェニルフェノラト) ガリウム、ビ ス(2-メチル-8-キノリノラト)(1-ナフトラ ト) ガリウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト) (2-ナフトラト) ガリウム、ビス (2-メチルー8-キノリノラト) (トリフェニルシラノラト) ガリウム、 30 ピス(2-メチル-8-キノリノラト)(トリス(4, 4-ビフェニル) シラノラト) ガリウム等が挙げられ る。特に好ましくは、ビス(2-メチル-8-キノリノ ラト) (2-ナフトラト) アルミニウム、ビス (2-メ チル-8-キノリノラト) (トリフェニルシラノラト) アルミニウムが挙げられる。

26

【0051】前記一般式 (IV) で表わされる二核金属錯 体の具体例として、ビス (2-メチル-8-キノラト) アルミニウム-μ-オキソービス-(2-メチル-8-キノリノラト) アルミニウム、ビス(2,4-ジメチル -8-キノリノラト) アルミニウム-μ-オキソービス - (2, 4-ジメチル-8-キノリノラト) アルミニウ ム、ピス(4-エチルー2-メチルー8-キノリノラ ト) アルミニウム-μ-オキソービス-(4-エチル-2-メチル-8-キノリノラト) アルミニウム、ビス (2-メチル-4-メトキシキノリノラト) アルミニウ ムールーオキソービスー (2ーメチルー4ーメトキシキ ノリノラト) アルミニウム、ビス (5-シアノー2-メ チルー8ーキノリノラト) アルミニウム-μ-オキソー ビスー (5-シアノー2-メチルー8-キノリノラト) ルー8-キノリノラト)(2-ナフトラト)アルミニウ 50 アルミニウム、ビス(5-クロロー2-メチルー8-キ

ノリノラト) アルミニウム-μ-オキソービス-(5-クロロー2-メチルー8-キノリノラト) アルミニウ ム、ビス(2-メチルー5-トリフルオロメチルー8-キノリノラト) アルミニウムールーオキソービスー (2 ーメチルー5ートリフルオロメチルー8ーキノリノラ ト) アルミニウム等が挙げられる。特に好ましくは、ビ ス(2-メチル-8-キノリノラト)アルミニウム-ル* *-オキソービスー(2-メチルー8-キノリノラト)ア ルミニウムが挙げられる。前記構造式 (V) で表わされ る1、2、4-トリアゾール環を少なくとも一個有する 化合物の具体例を以下に示す。

[0052]

【化15】

【0053】前記一般式 (VI) で表わされるスチリル化 合物の具体例としては、例えば以下に構造式を示すジス チリルビフェニル誘導体が挙げられる。

[0054]

【化16】

40

【0055】正孔阻止層6の膜厚は、通常、0.3~1 00nm、好ましくは0.5~30nmである。正孔阻 止層も正孔輸送層と同様の方法で形成することができる が、通常は真空蒸着法が用いられる。素子の発光効率を 更に向上させることを目的として、正孔阻止層6と陰極 8の間に電子輸送層7を設けることが考えられる。電子 輸送層7は、電界を与えられた電極間において陰極から 注入された電子を効率よく正孔阻止層6の方向に輸送す ることができる化合物より形成される。電子輸送層は、 発光層での再結合により生成するエキシトンが拡散して 陰極8で消光されるのを防ぐ効果を有する。電子輸送層 7に用いられる電子輸送性化合物としては、陰極8から の電子注入効率が高く、且つ、高い電子移動度を有し注 入された電子を効率よく輸送することができる化合物で あることが必要である。

【0056】このような条件を満たす材料としては、8 ヒドロキシキノリンのアルミニウム錯体等の金属錯体 (特開昭59-194393号公報), 10-ヒドロキ シベンゾ「h]キノリンの金屋錯体(特開平6-322

362号公報)、オキサジアゾール誘導体(特開平2-216791号公報) ジスチリルビフェニル誘導体 (特開平3-231970号公報)、シロール誘導体 (特開平9-87616号公報)、3又は5-ヒドロキ シフラボン金属錯体 (Appl. Phys. Let t., 71巻、3338頁、1997年)、ベンズオキ サゾール金属錯体(特開平6-336586号公報)、 ベンゾチアゾール金属錯体(特開平9-279134号 公報)、トリスベンズイミダゾリルベンゼン(米国特許 10 第5、645、948号明細書)、キノキサリン化合物 (特開平6-207169号公報)、フェナントロリン 誘導体 (特開平5-331459号公報)、2-t-ブ チルー9、10-N、N'-ジシアノアントラキノンジ イミン(Phys. Stat. Sol. (a), 142 巻、489頁、1994年)、n型水素化非晶質炭化シ リコン、n型硫化亜鉛、n型セレン化亜鉛等が挙げられ る。電子輸送層7の膜厚は、通常、5~200nm、好 ましくは10~100nmである。

30

【0057】陰極8は、電子輸送層7に電子を注入する 20 役割を果たす。陰極8として用いられる材料は、前記陽 極2に使用される材料を用いることが可能であるが、効 率よく電子注入を行うには、仕事関数の低い金属が好ま しく、スズ、マグネシウム、インジウム、カルシウム、 アルミニウム、銀等の適当な金属又はそれらの合金が用 いられる。具体例としては、マグネシウムー銀合金、マ グネシウムーインジウム合金、アルミニウムーリチウム 合金等の低仕事関数合金電極が挙げられる。

【0058】更に、陰極と発光層又は電子輸送層の界面 にLiF、Li2 O等のアルカリ金属化合物やアルカリ 30 土類ハロゲン化物等の極薄膜(0.1~5 nm)を挿入 することは、素子の効率を向上させる有効な方法である (Appl. Phys. Lett., 70巻, 152 頁, 1997年; IEEE Trans. Electr on. Devices, 44卷, 1245頁, 1997 年:特願平9-86662号明細書)。陰極8の膜厚は 通常、陽極2と同様である。低仕事関数金属から成る陰 極を保護する目的で、この上に更に、仕事関数が高く大 気に対して安定な金属層を積層することは素子の安定性 を増す。この目的のために、銅、アルミニウム、銀、ニ ッケル、クロム、金、白金等の金属が使われる。

【0059】尚、図1とは逆の構造、即ち、基板上に陰 極8、電子輸送層7、発光層5、正孔輸送層4、陽極2 の順に積層することも可能であり、既述したように少な くとも一方が透明性の高い二枚の基板の間に本発明の有 機電界発光素子を設けることも可能である。同様に、図 2及び図3に示した前記各層構成とは逆の構造に積層す ることも可能である。本発明の有機電界発光素子によれ ば、発光効率の高く、安定性に優れた白色発光が得ら れ、直視型の表示案子として有用であるばかりでなく、 50 バックライト光源としても機能し、更には、カラーフィ

ルタと組み合わせることによりフルカラー表示素子を作 製することも可能である。

[0060]

【実施例】次に、本発明を実施例によって更に具体的に 説明するが、本発明はその要旨を越えない限り、以下の 実施例の記載に限定されるものではない。

参考例1

ガラス基板をアセトンで超音波洗浄、純水で水洗、イソ プロピルアルコールで超音波洗浄、乾燥窒素で乾燥、U V/オゾン洗浄を行った後、真空蒸着装置内に設置し て、装置内の真空度が2×10-6Torr以下になるま で油拡散ポンプを用いて排気した。例示化合物(I-3)をセラミック坩堝に入れ、坩堝の周囲のタンタル線 ヒーターで加熱して蒸着を行った。この時の坩堝の温度 は、200~260℃の範囲で制御した。蒸着時の真空*

*度は1.8×10-6Torr(約2.3×10-4Pa) で、蒸着速度0.3mm/秒で膜厚82mmの一様で透 明な膜を得た。この薄膜試料のイオン化ポテンシャルを 理研計器 (株) 製の紫外線電子分析装置 (AC-1)を 用いて測定したところ、5.06eVの値を示した。こ の蒸着膜を水銀ランプ(波長 350 nm)で励起して **凋定した蛍光波長の極大は465mmで、青色の蛍光で** あった。また、例示化合物の粉末試料について、セイコ 一電子社製DSC-20により示差熱分析測定したとこ 10 ろTgは93℃と高い値を示した。同様にして、他の例 示化合物についてイオン化ポテンシャル、蛍光極大波 長、Tgを測定した結果を表-6に示す。

32

[0061]

【表6】

32 0							
化合物番号	イオン化 ポテンシャル [eV]	蛍光極大波 長 [nm]	Тg [℃]				
I-3	5.06	465	93				
I- 5	5.08	445	88				
I-10	5.00	450	146				
I-27	5.09	470	142				
I-28 .	5.05	480	120				

【0062】参考例2

正孔輸送層の材料としては、例示化合物(I-3)に代 30 【0065】 えて、以下に示す4、4′ービス[N-(1-ナフチ ν) -N-フェニルアミノ] ビフェニル <math>(H-1) を蒸 着源と

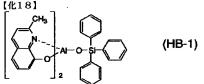
[0063]

【0064】した他は参考例1と同様にして蒸着膜を作 製した。この薄膜試料のイオン化ポテンシャルを測定し たところ、5.25eVの値を示した。

参考例3

正孔阻止層の材料として、例示化合物(I-3)に代え て、下記に示すビス(2-メチル-8-キノリノラト) (トリフェニルシラノラト) アルミニウム錯体 (HB-

※作製した。



【0066】この薄膜試料のイオン化ポテンシャルを測 定した結果、5.51eVであった。

40 実施例1

図2に示す構造を有する有機電界発光素子を以下の方法 で作製した。ガラス基板上にインジウム・スズ酸化物 (ITO)透明導電膜を120nm堆積したもの(ジオ マテック社製;電子ビーム成膜品;シート抵抗15Ω) を通常のフォトリソグラフィ技術と塩酸エッチングを用 いて2mm幅のストライプにパターニングして陽極を形 成した。パターン形成したITO基板を、アセトンによ る超音波洗浄、純水による水洗、イソプロピルアルコー ルによる超音波洗浄の順で洗浄後、窒素ブローで乾燥さ 1)を蒸着源とした他は参考例1と同様にして蒸着膜を※50 せ、最後に紫外線オゾン洗浄を行って、真空蒸着装置内 に設置した。上記装置の租排気を油回転ポンプにより行った後、装置内の真空度が2×10-6Torr(約2.7×10-4Pa)以下になるまで液体窒素トラップを備えた油拡散ポンプを用いて排気した。

【0067】正孔輸送層材料として、4,4´ービス (N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ)ビフェニル(H-1)をセラミック坩堝に入れ、坩堝の周囲の タンタル線ヒーターで加熱して蒸着を行った。この時の坩堝の温度は、275~280℃の範囲で制御した。蒸着時の真空度は1.1×10-6Torr(約1.5×1 10-4Pa)で、蒸着速度0.3nm/秒で膜厚60nmの正孔輸送層4を得た。次に、発光層5を、例示化合物 (I-10)をホスト材料として、下記に構造式を示すルプレン(D-1)をドープ蛍光色素として、二元同時蒸着法により、上記正孔輸送層4の上に蒸着を行った。【0068】

(D-1)

(D-1)

【0069】この時の例示化合物(I-10)の坩堝温 度は320~330℃の範囲で、ルブレンの坩堝温度は 200℃で制御した。蒸着時の真空度は1.1×10-6 Torr (約1. 5×10-4Pa) で、ホスト材料の蒸 着速度0.2 nm/秒で、膜厚は30 nmであった。こ 30 の時、最初の膜厚15nmの領域で、ルブレン坩堝のシ ャッタを開けずにドープしない領域とし、後半の15 n mの領域ではルブレンがホスト材料に対して0.4重量 %となるようにした。続いて、正孔阻止層6の材料とし て、ビス(2ーメチルー8ーキノリノラト)(トリフェ ニルシラノラト) アルミニウム錯体 (HB-1) を上記 発光層5の上に同様にして蒸着を行った。 この時の坩堝 の温度は180~190℃の範囲で制御した。蒸着時の 真空度は8.0×10-7Torr (約1.1×10-4P a) で、蒸着速度 0.5 nm/砂で、膜厚は 20 nmで 40 あった。更に、電子輸送層7の材料として以下に示すア ルミニウムの8-ヒドロキシキノリン錯体(E-1)を 上記正孔阻止層6の上に同様にして蒸着を行った。

.【0070】 【化20】 (E-1)

34

【0071】この時の坩堝の温度は300~310℃の 範囲で制御した。蒸着時の真空度は8.0×10⁻⁷To rr(約1.1×10⁻⁴Pa)で、蒸着速度0.3nm /秒で、膜厚は25nmであった。上記の正孔輸送層4 から電子輸送層7を真空蒸着する時の基板温度は室温に 保持した。

【0072】ここで、電子輸送層7までの蒸着を行った 素子を一度前記真空蒸着装置内より大気中に取り出し て、陰極蒸着用のマスクとして2mm幅のストライプ状 シャドーマスクを、陽極2のITOストライプとは直交 するように素子に密着させて、別の真空蒸着装置内に設 置して有機層と同様にして装置内の真空度が2×10-6 20 Torr (約2. 7×10-4Pa) 以下になるまで排気 した。陰極8として、先ず、フッ化マグネシウム(Mg F2)をモリブデンボートを用いて、蒸着速度0.04 nm/秒、真空度5.0×10-6Torr(約6.7× 10-4Pa)で、0.5nmの膜厚で電子輸送層7の上 に成膜した。次に、アルミニウムを同様にモリブデンボ ートにより加熱して、蒸着速度0.5nm/秒、真空度 1. 2×10⁻⁵Torr (約1. 6×10⁻³Pa)で膜 厚40 nmのアルミニウム層を形成した。 更に、その上 に、陰極の導電性を高めるために銅を、同様にモリブデ ンボートを用いて加熱して、蒸着速度0.4 nm/秒、 真空度1.2×10-5Torr(約1.6×10-3P a)で膜厚40nmの銅層を形成して陰極8を完成させ た。以上の三層型陰極8の蒸着時の基板温度は室温に保 持した。

【0073】以上の様にして、2mm×2mmのサイズの発光面積部分を有する有機電界発光素子が得られた。この素子の発光特性を表-7に示す。表-7において、発光輝度は250mA/cm²の電流密度での値、発光効率は100cd/m²での値、輝度/電流密度特性の傾きを、電圧は100cd/m²での値を各々示す。CIE色度座標値(JIS Z8701)を合わせて示す。ELスペクトルを図5に示す。発光色は白色であった。この素子は長期間保存後も、駆動電圧の顕著な上昇は見られず、発光効率や輝度の低下もなく、安定した素子の保存安定性が得られた。

【0074】 【表7】

36

	麦 — 7						
	発光度	発光輝度 [cd/m²]	発光 効率 [/ m/W]	輝度/電流	電圧 [V]	CIE 色	度座標
	材料		@100 cd/m ²	[cd/A]	@100 cd/m ²	×	У
実施例 1	(l-10)	9955	2.88	7.3	8	0.358	0.408
実施例2	(1-27)	8480	1.66	. 4.8	9	0.317	0.346
実施例3	(1-3)	3970	0.62	2.6	13	0.267	0.287
	(I-10)	3820	0.81	2.6	10	0.176	0.195
参考例4	(I-27)	6890	1.69	4.3	8	0.202	0.301
	(1-3)	6420	1.34	3.8	9	0.220	0.359
比較例1	(I-27)	6590	1.51	2.4 -	5	0.412	0.514
比較例 2	(1-3)	2330	0.26	1.0	12	0.336	0.402
·比較例3	(HB-1)	1290	0.38	1.5	13	0.345	0.354

【0075】実施例2

発光層のホスト材料として例示化合物(I-27)を、 ドープ蛍光色素を以下の構造式に示すベンゾチオキサン テン誘導体 (D-2) とした他は実施例1と同様 [0076]

【化21】

【0077】にして素子を作製した。素子の発光特性を 表-7に示す。ELスペクトルを図6に示す。発光色は 白色であった。

実施例3

発光層のホスト材料として例示化合物(I-3)を、正 孔輸送層側の膜厚15nmの領域におけるドープ蛍光色 素としてペリレンを、正孔阻止層側の膜厚15 nmの領 40 【0080】 域におけるドープ蛍光色素を以下の構造式に示すアザベ*

*ンゾチオキサンテン誘導体(D-3)とした他は実施例 1と同様にして素子を作製した。

[0078]

【0079】累子の発光特性を表-7に示す。

実施例1で作製した素子を、電圧を変えて輝度レベルを 変化させて発光スペクトルを測定し、色度座標を求めた 結果を表-8に示す。色度座標値は若干変動するが、い ずれも白色発光領域であり、実用上は問題のない程度で あった。

【表8】

3 X — 8							
電圧 [V]	輝度 [cd/m²]	CIE色	度座標				
-GAL (*)	ATAZ (CORINI)	х	У				
8	109.	0.363	0.412				
10	720	0.358	0.408				
14	9955	0.345	0.393				

【0081】参考例4

発光層材料に例示化合物(I-10)、(I-27)及び(I-3)を用い、発光層にドープしない他は実施例1と同様にして素子を作製した。これらの素子の発光特性を表-7に示す。いずれも青色、青緑色の発光色であった。これらドープしない素子の色度座標と実施例1~3で用いたドープ色素の溶液での蛍光スペクトルから求めた色度座標値を図7に示す。

37

【0082】比較例1

正孔阻止層を設けず、電子輸送層の膜厚を45nmとし 20 た他は実施例2と同様に素子を作製した。この素子の発光特性を表-7に示す。背色発光は得られず、電子輸送層として用いたアルミニウムの8-ヒドロキシキノリン 錯体からの発光にドープ色素が加わった黄緑色発光が観測された。

比較例2

正孔輸送層を設けず、発光層材料を例示化合物(I-3)として、その膜厚を60nmとし、ドープ色素としてアザベンゾチオキサンテン(D-3)を用いた他は実施例1と同様にして素子を作製した。この素子の発光特 30性を表-7に示す。白色発光は得られたものの発光効率は低かった。

【0083】比較例3

青色発光層ホスト材料として前記化合物(HB-1)を用い、ペリレンとペンゾチオキサンテン(D-2)を各々1.0、0.4重量%ドープし、正孔阻止層を設けず電子輸送層として45nmの(E-1)を用いた他は実施例1と同様にして素子を作製した。この素子の発光物率は低かった。

[0084]

【発明の効果】本発明の有機電界発光素子によれば、特定の芳香族アミンからなる発光層に特定の発光色素を含*

* 有させるために、高い発光効率の白色発光が達成でき、また安定性の向上した素子を得ることができる。従って、本発明による有機電界発光素子はフラットパネルディスプレイ (例えば〇Aコンピュータ用や壁掛けテレビ) やマルチカラー表示素子、或いは面発光体としての特徴を生かした光源 (例えば、複写機の光源、液晶ディスプレイや計器類のバックライト光源)、表示板、標識等への応用が考えられ、特に、高耐熱性が要求される車載用、屋外用表示素子としては、その技術的価値は大きいものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】有機電界発光素子の一例を示した模式断面図。 【図2】有機電界発光素子の別の例を示した模式断面 図。

【図3】有機電界発光素子の別の例を示した模式断面 図

【図4】加法混色の概念を示したCIE色度座標図。

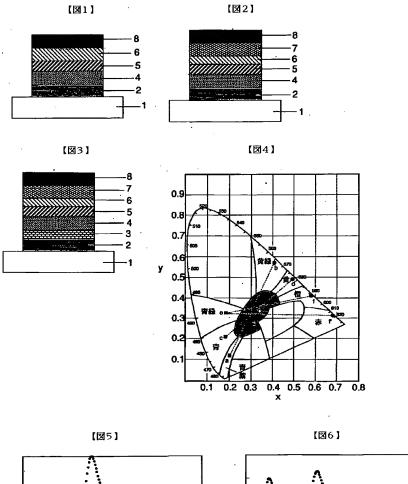
【図5】実施例1の有機電界発光素子からの発光スペクトル.

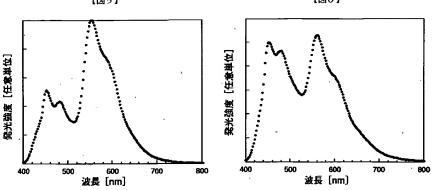
3 【図6】実施例2の有機電界発光素子からの発光スペクトル

【図7】実施例1~3に用いたホスト及びドープ色素からの発光のCIE色度座標図。

【符号の説明】

- 1 基板
- 2 陽極
- 3 陽極バッファ層
- 4 正孔輸送層
- 5 発光層
- 6 正孔阻止層
- 7 電子輸送層
- 8 陰極





【図7】

